

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第2区分

【発行日】平成19年1月11日(2007.1.11)

【公表番号】特表2006-507337(P2006-507337A)

【公表日】平成18年3月2日(2006.3.2)

【年通号数】公開・登録公報2006-009

【出願番号】特願2004-554535(P2004-554535)

【国際特許分類】

C 07 C 67/52 (2006.01)

C 07 C 69/732 (2006.01)

C 07 C 231/24 (2006.01)

C 07 C 235/34 (2006.01)

C 09 K 15/08 (2006.01)

C 09 K 15/24 (2006.01)

【F I】

C 07 C 67/52

C 07 C 69/732 Z

C 07 C 231/24

C 07 C 235/34

C 09 K 15/08

C 09 K 15/24

【手続補正書】

【提出日】平成18年11月16日(2006.11.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

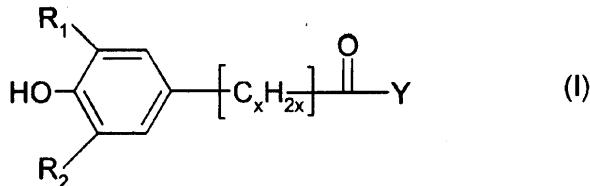
【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

式

【化1】



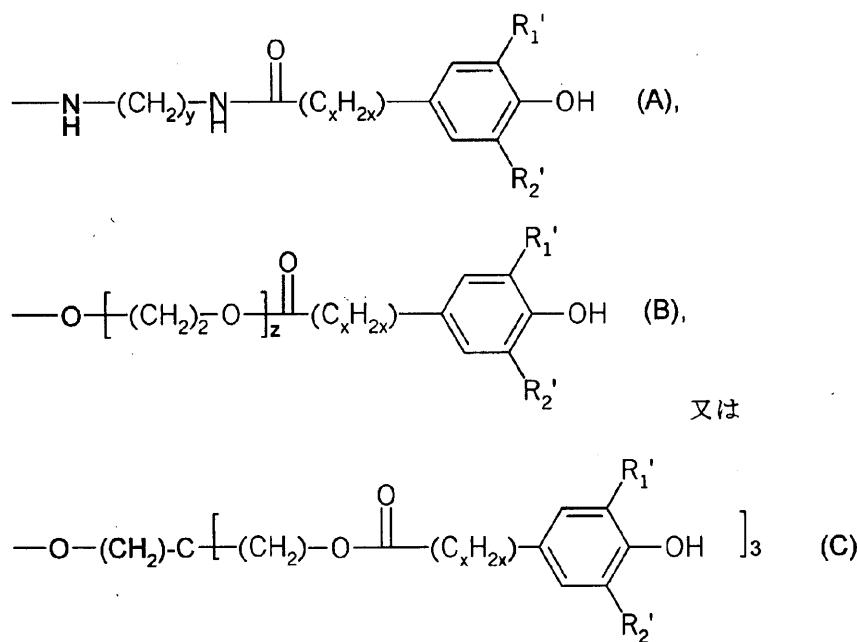
[式中、

R₁及びR₂の一方は、互いに独立して、水素原子又は炭素原子数1ないし4のアルキル基を表わし、他方は炭素原子数3ないし4のアルキル基を表わし；

xは、0(直接結合)又は1ないし3の数を表わし；及び、

Yは、炭素原子数8ないし22のアルコキシ基、又は部分式

【化2】



(式中、

R_1' 及び R_2' の一方は、互いに独立して、水素原子又は炭素原子数 1 ないし 4 のアルキル基を表わし、他方は炭素原子数 3 ないし 4 のアルキル基を表わし；

x は、0 (直接結合) 又は 1 ないし 3 の数を表わし；

y は、2 ないし 10 の数を表わし：及び、

z は、2 ないし 6 の数を表わす。) で表わされる基を表わす。] で表わされる化合物を本質的に結晶形態で含む固体粒子の製造方法であって、該方法は、前記化合物 (I) (式中、 R_1 、 R_2 、 R_1' 、 R_2' 、Y、 x 、 y 及び z は、上記で定義した通りである。) 又はその混合物を含む均一な水性分散液を製造し、ポリオキシエチレンソルビタンの脂肪酸部分エステル及び種結晶の添加によって結晶を形成させ、得られた結晶を分散液から分離することを特徴とする方法。

【請求項2】

本質的に結晶形態で化合物 (I) [式中、 R_1 及び R_2 の一方が、互いに独立して、水素原子又は第三ブチル基を表わし、他方は第三ブチル基を表わし；

x は、2 を表わし；及び、

Y は、炭素原子数 8 ないし 22 のアルコキシ基、又は前記部分式 (A)、(B) 又は (C) で表わされる基 (式中、 R_1' 及び R_2' の一方は、互いに独立して、水素原子又は第三ブチル基を表わし、他方は第三ブチル基を表わし；

x は 2 を表わし； y は 6 を表わし；及び z は 3 を表わす。) を表わす。] 又はその混合物を含む固体粒子を製造するための方法であって、ポリオキシエチレン - (20 又は 5) - ソルビタンモノオレエートの添加によって結晶を形成させることを特徴とする、請求項 1 記載の方法。

【請求項3】

a) 本質的に結晶形態でペンタエリトリトールテトラキス [3 - (3, 5 - ディ - 第三ブチル - 4 - ヒドロキシフェニル) - プロピオネート]；

b) ポリオキシエチレンソルビタンの脂肪酸部分エステル；及び、

c) 水

を含む水性分散液。

【請求項4】

a) 本質的に結晶形態で N, N' - ヘキサン - 1, 6 - ディル - ビス [3 - (3, 5 - ディ - 第三ブチル - 4 - ヒドロキシフェニルプロピオンアミド)]；

- b) ポリオキシエチレンソルビタンの脂肪酸部分エステル；及び、
c) 水

を含む水性分散液。

【請求項 5】

X線粉末回折パターンにおいて、以下の格子面間隔 [d - 値] 及び以下の主線の相対線強度

d - 間隔 []	相対強度
2 2 . 7	高強度
1 9 . 7	高強度
1 4 . 9	中強度
1 3 . 1	中強度
1 1 . 3	中強度
9 . 0	低強度
8 . 6	中強度
7 . 6	低強度
7 . 1	非常に高強度
6 . 6	低強度
5 . 9 4	低強度
5 . 6 3	中強度
5 . 4 5	低強度
5 . 2 6	中強度
5 . 0 6	中強度
4 . 8 2	中強度
4 . 7 4	高強度
4 . 5 8	中強度
4 . 4 3	非常に高強度
4 . 3 0	低強度
4 . 0 9	低強度
3 . 9 3	低強度
3 . 7 5	低強度

を特徴とする、結晶形態のペンタエリトリトルテトラキス[3-(3,5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)-プロピオネート]。

【請求項 6】

X線粉末回折パターンにおいて、以下の格子面間隔 [d - 値] 及び相対線強度

d - 間隔 []	相対強度
2 2 . 7	高強度
1 9 . 7	高強度
1 4 . 9	中強度
1 3 . 1	中強度
1 2 . 4	非常に低強度
1 1 . 3	中強度
1 0 . 9	非常に低強度
9 . 9	非常に低強度
9 . 0	低強度
8 . 6	中強度
7 . 6	低強度
7 . 1	非常に高強度
6 . 6	低強度
6 . 3	非常に低強度
5 . 9 4	低強度

5 . 8 1	非常に低強度
5 . 6 3	中強度
5 . 4 5	低強度
5 . 3 5	非常に低強度
5 . 2 6	中強度
5 . 0 6	中強度
4 . 9 3	低強度
4 . 8 2	中強度
4 . 7 4	高強度
4 . 5 8	中強度
4 . 5 2	低強度
4 . 4 3	非常に高強度
4 . 3 0	低強度
4 . 1 3	非常に低強度
4 . 0 9	低強度
3 . 9 3	低強度
3 . 7 5	低強度
3 . 5 9	非常に低強度
3 . 4 2	非常に低強度
3 . 3 3	非常に低強度
3 . 2 5	非常に低強度
3 . 1 6	非常に低強度
3 . 0 6	非常に低強度

を特徴とする、請求項5記載の結晶形態であるペンタエリトリトールテトラキス[3-(3,5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル)-プロピオネート]の結晶変性物(μ -形態)。

【請求項7】

X線粉末回折パターンにおいて、以下の格子面間隔[d-値]及び主線及びより弱い線を含めた相対線強度

d - 間隔 []	相対強度
1 1 . 1	低強度
1 0 . 3	中強度
7 . 9	中強度
7 . 3	中強度
5 . 1 3	高強度
5 . 0 6	高強度
4 . 8 8	中強度
3 . 9 2	低強度

を特徴とする、N,N'-ヘキサン-1,6-ジイル-ビス[3-(3,5-ジ-第三ブチル-4-ヒドロキシフェニル-プロピオニアミド)]の結晶形態。

【請求項8】

X線粉末回折パターンにおいて、以下の格子面間隔[d-値]及び主線及びより弱い線を含めた相対線強度

d - 間隔 []	相対強度
1 6 . 0	非常に低強度
1 3 . 6	非常に低強度
1 2 . 7	非常に低強度
1 1 . 1	低強度
1 0 . 5	中強度
1 0 . 3	中強度

9 . 1	非常に低強度
8 . 5	低強度
8 . 0	中強度
7 . 9	中強度
7 . 5	中強度
7 . 3	中強度
7 . 1	中強度
6 . 8	低強度
6 . 4	低強度
6 . 2	中強度
6 . 1	中強度
5 . 9 4	低強度
5 . 8 3	非常に低強度
5 . 5 8	中強度
5 . 2 4	中強度
5 . 1 3	高強度
5 . 0 6	高強度
4 . 9 8	中強度
4 . 8 8	中強度
4 . 7 1	中強度
4 . 5 9	高強度
4 . 5 4	高強度
4 . 3 8	高強度
4 . 2 4	中強度
4 . 1 3	中強度
3 . 9 2	低強度
3 . 8 5	低強度
3 . 7 1	非常に低強度
3 . 5 3	低強度
3 . 3 8	非常に低強度
3 . 2 9	非常に低強度
3 . 0 5	非常に低強度

を特徴とする、N , N' - ヘキサン - 1 , 6 - ジイル - ビス [3 - (3 , 5 - ジ - 第三ブチル - 4 - ヒドロキシフェニル - プロピオンアミド)] の結晶変性物 (- 形態) 。